CdSe





描述

我司的CdSe产品,又称硒化镉晶体。是一种综合性能出色的非线性晶体疾操测病或阻能电热或格光过极高,高能放致宽,光学吸收低,光学电学性能优异的特点。可以用在偏光器,光束器,DFM转换器,光学参量振荡产品之中。

特点

- 小的双折射和离散角
- 宽广的相位匹配波段
- 。优异的光学、电学性能
- 8~15µm波段无声子吸收
- 透光波段宽 (0.75至25µm)
- 有效非线性系数中等 (d31=18pm/V)
- 。极低的光学吸收(<0.01cm-1, 1~10μm)

应用

- 光电子
- 偏光器
- 分束器
- 红外光学真
- 空沉积源太
- 阳能电池
- 发光二极管
- DFM转换器
- 高能射线探测功能
- 性晶体管
- 光学参量振荡室温
- 核辐射探测器

CdSe



基本参数

| 结构 | 纤锌矿(六边) | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 晶体生长 | HPVB / HPVZM | | |
| 密度 | 5.81 g/ cm3 | | |
| 杨氏模量 | 5×1011 dyne/cm2 | | |
| 热膨胀系数 (500 K) | α1=6.26×10-6/K; | | |
| ARM/MARSX (JUU R) | α3=4.28×10-6/K | | |
| 比热容 | 0.49 J/gK | | |
| 热导率(@25℃): | 0.04 W/cmK | | |
| Eg, eV (E // <0001>, 300 K) | 1.73 | | |
| Eg, eV (E⊥<0001>, 300 K) | 1.705 | | |
| 最大透射率(λ=2.5-15 μm): | ≥ 71 % | | |
| 吸收系数 (λ=10.6 μm): | ≤0.0015 cm-1 (including 2 surfaces) | | |
| 折射率(λ=10.6 μm): | no= 2.4258, ne=2.4437 | | |
| 最大单晶尺寸 | Ø50.8×40 mm | | |
| 最大红外光学毛坯尺寸 | Ø50×50 mm, | | |
| 取八年行列于七年代的 | 60×60×6 mm | | |
| 表面质量 | 原切割, 60/40 scratch*dig per MIL-0-13830 | | |
| 电阻率 | 低:<1 Ohm*cm高:> | | |
| <u>₽₩+</u> | 1012 Ohm*cm | | |

Sellmeier方程系数 (T=300 K)

$n^2 = A + B/(1 - C/\lambda^2) + D/(1 - E/\lambda^2)$

| Sellmeier系数 | no | ne | |
|-------------|---------|---------|--|
| A | 4.1318 | 4.0832 | |
| В | 1.8584 | 2.0041 | |
| C [um2] | 0.21999 | 0.20646 | |
| D | 2.7673 | 3.9928 | |
| E [um2] | 2962.98 | 3866.93 | |

标品(例)

| 面尺寸(mm) | 长度(mm) | θ | PHI | 应用 | 涂层 |
|---------|--------|-----|-----|---------------------|------------------------------------|
| 5×5 | 1 | 39° | 45° | DFG@1, 2-2, 4µm, I型 | BBar/BBar@1.2-2.4/2.4-11µm, AOI=0° |
| 8×8 | 1 | 39° | 45° | DFG@1, 2-2, 4µm, I型 | BBar/BBar@1.2-2.4/2.4-11µm, AOI=0° |
| 6×6 | 2 | 50° | 0° | DFG@1, 2-2, 4µm, I型 | BBar/BBar@1.2-2.4/2.4-11µm, AOI=0° |
| 8×8 | 2 | 50° | 0° | DFG@1, 2-2, 4µm, I型 | BBar/BBar@1.2-2.4/2.4-11µm, AOI=0° |

CdSe

谱图





